

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XZ100F	文件编号	XS-R-132
	整流二极管	版本号	18-A1-09
		页码	1/3

1 主要用途及主要特点

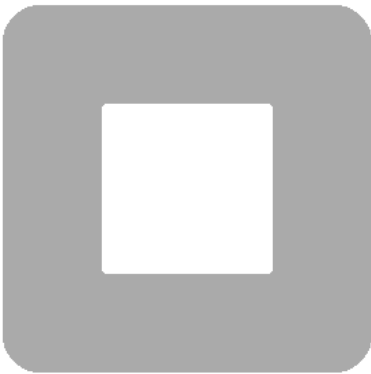
1.1 主要用途

用 W1XZ100F 封装的成品管主要用于各类整流电路中。

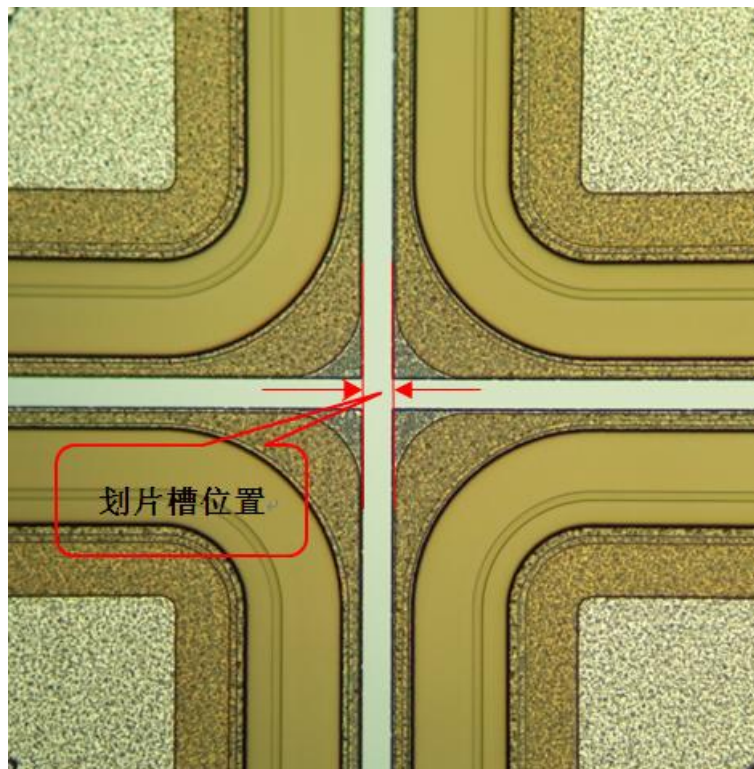
1.2 主要特点

- 低正向压降
- 低反向漏电
- 高可靠性

2 芯片数据

芯片示意图 	芯片尺寸	1.00 mm×1.00 mm	
		39.37 mil×39.37 mil	
	芯片厚度 (μm) (推荐)	220±20	
	划片道*尺寸 (μm)	40	
	键合区面积 (μm ²)	正面	450×450
	正面电极 (阳极)	金属	铝
		厚度 (μm)	5.0±1.0
	背面电极 (阴极) (推荐)	表层金属	银
	硅片直径 (mm)	φ125	
	装片要求 (推荐)	低温共晶	
键合要求 (推荐)	铜丝; φ32 μm; 2 根		

* 划片道位置示意图:



江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

电话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XZ100F	文件编号	XS-R-132
	整流二极管	版本号	18-A1-09
		页码	2/3

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

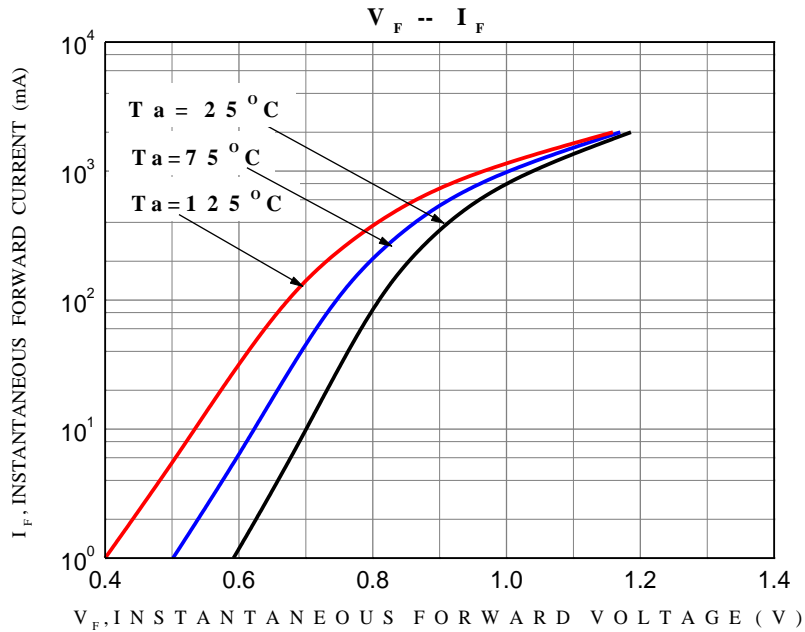
参数名称	符号	额定值	单位	备注
峰值反向电压	V_{RM}	800	V	推荐封装形式: SOD-123 推荐成品型号: 2CZ4006
正向电流	$I_{F(AV)}$	1 (单胞)	A	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_R=100\mu\text{A}$	800	—	—	V
反向电流	I_R	$V_R=800\text{V}$	—	—	5	μA
正向电压	V_F	$I_F=1\text{A}$	—	—	1.1	V

3.3 典型特性曲线



江阴新顺微电子有限公司

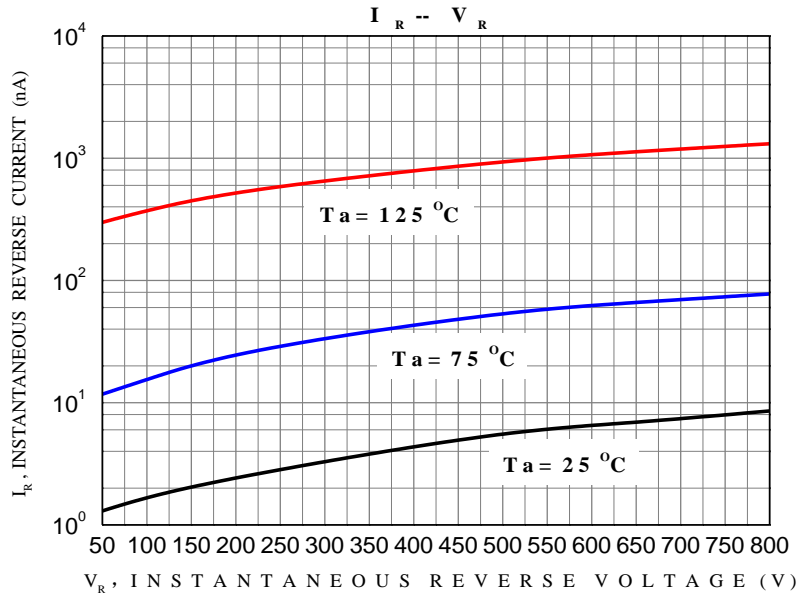
地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XZ100F	文件编号	XS-R-132
	整流二极管	版本号	18-A1-09
		页码	3/3



注意事项:

- 芯片存储条件 (推荐): 氮气保护, 温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
电 话: (0510) 86851182

网 址: <http://www.xs-elec.com>
传 真: (0510) 86851532